

УДК 539.3

МОДЕЛЬ ТОНКОГО КРИВОЛІНІЙНОГО ТЕРМОПРУЖНОГО ВКЛЮЧЕННЯ

Любомир Тисовський

Український державний лісотехнічний університет

Загальна схема розв'язування задач про визначення напружено-деформованого стану в тілах з сторонніми включеннями полягає в сумісному розв'язку рівнянь рівноваги для області, зайнятої основним матеріалом (матриці), і області, зайнятої включенням. Потім отримані розв'язки спрягаються по лінії розділу матеріалів шляхом задоволення граничних умов. Однак згаданий підхід досить трудомісткий особливо тоді, коли геометричні розміри включення не є співмірними. В цьому випадку виникають сильно неоднорідні поля шуканих характеристик. Якщо врахувати тонкостінність прошарку і його механічні та теплофізичні характеристики, то можна ввести різні спрощення в постановку і розв'язування задачі. Один з таких підходів пропонуємо нижче.

Розглянемо безмежну матрицю, яка містить криволінійне тонкостінне пружне включення постійної ширини $2h$. Серединну лінію включення позначимо через L з додатним напрямом обходу на ній проти ходу годинникової стрілки. Композит перебуває в заданому зовнішньому температурному і силовому полі, а на лінії розділу матеріалів виконуються умови ідеального механічного і теплового контакту, які можна зобразити так:

теплові

$$\begin{aligned} (T_* + i\eta)_0|_{\delta=\pm h} &= (T_* + i\eta)|_{\delta=\pm h}, \\ \kappa_0 \frac{\partial}{\partial n} (T_* + i\eta)_0|_{\delta=\pm h} &= \kappa \frac{\partial}{\partial n} (T_* + i\eta)|_{\delta=\pm h}; \end{aligned} \quad (1)$$

механічні

$$\begin{aligned} (N + iT)_0|_{\delta=\pm h} &= (N + iT)|_{\delta=\pm h}, \\ \frac{\partial}{\partial t} (u + iv)_0|_{\delta=\pm h} + i\gamma &= \frac{\partial}{\partial t} (u + iv)|_{\delta=\pm h}, \end{aligned} \quad (2)$$

де $N \equiv N(t)$; $T \equiv T(t)$; $u \equiv u(t)$; $v \equiv v(t)$; $T_* \equiv T_*(t)$ – відповідно нормальна і дотична компоненти зовнішніх зусиль; компоненти вектора переміщень і температура, обчислені в точці t ліній розділу матеріалів; $\eta = \eta(t)$ – допоміжна гармонійна функція; κ – коефіцієнт теплопровідності; γ – поворот тонкого включення як жорсткого цілого; $i = \sqrt{-1}$ – уявна одиниця; δ – відрізок перпендикуляра, проведеного до лінії L в точці t . Тут і далі всі характеристики тонкого включення позначають індексом «0», а характеристики матриці вживають без індексів.

Припустимо, що композит перебуває в умовах плоскої задачі термопружності, тобто напружено-деформований стан і температурне поле в тілі можна зобразити комплексними потенціалами Колосова – Мусхелішвілі $\Phi(z)$, $\Psi(z)$ і комплексні потенціали температурного поля $F_1(z)$, $Q_1(z)$

$$N + iT = \Phi(z) + \overline{\Phi(z)} + \frac{d\bar{z}}{dz} [z\overline{\Phi'(z)} + \overline{\Psi(z)}],$$

$$2\mu \frac{\partial}{\partial t}(u + iv) = \chi\Phi(z) - \overline{\Phi(z)} -$$

$$- \frac{d\bar{z}}{dz} [z\overline{\Phi'(z)} + \overline{\Psi(z)}] + H[F_1(z) + \overline{Q_1(z)}], \quad (3)$$

$$T_* + i\eta = F_1(z) + Q_1(\bar{z}). \quad (4)$$

Тут σ_x , σ_y , τ_{xy} – компоненти тензора напружень; $H = \alpha_t E$, $\chi = 3 - 4\nu$ – для плоскої деформації і $H = \alpha_t E/(1 + \nu)$, $\chi = (3 - \nu)/(1 + \nu)$ – для плоского деформованого стану; α_t – температурний коефіцієнт лінійного розширення; ν – коефіцієнт Пуассона; $\mu = E/(2(1 + \nu))$ – модуль зсуву; E – модуль Юнга; z – комплексна змінна.

Нехай тепер тонкостінне включення буде геометричним об'єктом, який утворюється так. З точки $u \in L$ відкладаємо по нормалі до L в одну і іншу сторону відрізок довжиною h . Тоді біжуча координата сторін включення визначається співвідношенням

$$t^\pm = u \pm he^{i\alpha}, \quad \alpha = \alpha(u),$$

де t^+ , t^- – відповідно точки лівого і правого берегів включення по відношенню до вибраного додатного напрямку; α – кут, який становить нормаль до контура з віссю Ox .

Скориставшись поняттям похідної за напрямом, зі співвідношення (4) можна отримати

$$\frac{\partial}{\partial n}(T_* + i\eta) = e^{i\alpha}F(z) + e^{-i\alpha}Q(\bar{z}),$$

$$\frac{\partial}{\partial s}(T_* + i\eta) = -i(e^{i\alpha}F(z) - e^{-i\alpha}Q(\bar{z})),$$

де $F(z) = F_1'(z)$, $Q(z) = Q_1'(z)$.

Запишемо співвідношення (3), (5) для області, зайнятої тонким включенням і, враховуючи тонкостінність прошарку, розвинемо комплексні потенціали Колосова – Мусхелішвілі і функції $F(z)$, $Q(z)$ в ряди Тейлора в околі точки $u \in L$. Залишаючи в одержаних розкладах лише члени першого порядку малості порівняно з h , після перетворень одержимо

$$\frac{\partial}{\partial s}(T_* + i\eta)_0^+ - \frac{\partial}{\partial s}(T_* + i\eta)_0^- = 2h\rho'(u),$$

$$\frac{\partial}{\partial n}(T_* + i\eta)_0^+ - \frac{\partial}{\partial n}(T_* + i\eta)_0^- = 2hg'(u), \quad (6)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial s}(T_* + i\eta)_0^+ + \frac{\partial}{\partial s}(T_* + i\eta)_0^- &= -2i[e^{i\alpha}F_0(u) - e^{-i\alpha}Q_0(\bar{u})], \\ \frac{\partial}{\partial n}(T_* + i\eta)_0^+ + \frac{\partial}{\partial n}(T_* + i\eta)_0^- &= 2[e^{i\alpha}F_0(u) + e^{-i\alpha}Q_0(\bar{u})],\end{aligned}\quad (7)$$

$$\begin{aligned}(N + iT)_0^+ - (N + iT)_0^- &= 2hK'(u), \\ \frac{\partial}{\partial t}(u + iv)_0^+ - \frac{\partial}{\partial t}(u + iv)_0^- &= \frac{h}{\mu_0}M'(u),\end{aligned}\quad (8)$$

$$\begin{aligned}(N + iT)_0^+ + (N + iT)_0^- &= 2[\Phi_0(u) + \overline{\Phi_0(u)} - e^{-2i\alpha}R_0(u)], \\ \frac{\partial}{\partial t}(u + iv)_0^+ + \frac{\partial}{\partial t}(u + iv)_0^- &= \\ &= \frac{1}{\mu_0}[\chi_0\Phi_0(u) - \overline{\Phi_0(u)} + e^{-2i\alpha}R_0(u) + 2H_0f_0(u)].\end{aligned}\quad (9)$$

Функції стрибка потоків тепла $\rho'(u)$, $g'(u)$, контактних напружень $K'(u)$ і похідних від вектора переміщень $M'(u)$ у точці u кривої L пов'язані з комплексними потенціалами співвідношеннями

$$\begin{aligned}\rho'(u) &= -i[e^{2i\alpha}F'_0(u) - e^{-2i\alpha}Q'_0(\bar{u})], \\ g'(u) &= e^{2i\alpha}F'_0(u) + e^{-2i\alpha}Q'_0(\bar{u}), \\ K'(u) &= e^{i\alpha}\Phi'_0(u) - e^{-i\alpha}\overline{\Phi'_0(u)} + e^{-i\alpha}R'_0(u), \\ M'(u) &= \chi_0e^{i\alpha}\Phi'_0(u) + e^{-i\alpha}\overline{\Phi'_0(u)} - e^{-i\alpha}R'_0(u) + H_0e^{i\alpha}f'_0(u), \\ R_0(u) &= u\overline{\Phi'_0(u)} + \overline{\Psi_0(u)}.\end{aligned}\quad (10)$$

Отже, співвідношеннями (6)–(10) повністю описуються умови взаємодії криволінійного тонкого термопружного включення з навколишнім середовищем. Співвідношення (6), (8) треба вважати визначальними для функцій стрибка відповідних теплових і пружних компонент, а співвідношення (7), (9) і є власне моделлю тонкого включення.

Накінець, зауважимо, що:

а) функція f_0 , дійсна частина якої має фізичний зміст температури, перебуває у процесі розв'язування задачі теплопровідності;

б) якщо в співвідношеннях (8)–(9) прийняти, що $f_0(u) \equiv 0$, то отримаємо модель тонкого криволінійного пружного включення [1];

в) одержані умови взаємодії тонкого включення з навколишнім середовищем є досить загальними і дають змогу отримати розв'язок у широкому діапазоні зміни як пружних, так і теплофізичних характеристик задачі: від тріщини до абсолютно жорсткого включення і від абсолютно теплопровідної тріщини (включення) до теплоізолюваної тріщини (включення). Приймаючи, що $\alpha = \pi/2$ одержимо модель прямолінійного тонкого термопружного включення [2].

1. Грилицкий Д. В., Опанасович В. К., Тисовский Л. О. Упругое равновесие изотропной пластины с криволинейным тонким упругим включением // Прикл. механика. – 1989. – Т. 26, № 12. – С. 86–93.
2. Грилицкий Д. В., Драган М. С., Опанасович В. К. Температурное поле и термоупругое состояние пластин с тонкостенным упругим включением // Прикл. математика и механика. – 1980. – Т. 44, Вып. 2. – С. 338–345.

A MODEL OF A THIN CURVELINEAR ELASTIC INCLUSION FOR THE PLANAR PROBLEM OF THERMOELASTICITY

Lubomir Tisowskij

Ukrainian state forestry engineering university

This paper is concerned with the problem, of a thin curvelinear elastic inclusion in an infinite isotropic medium under the action of a temperature field. Taking account of the thin – walled nature of an inclusion, let us expand the complex potentials in a Taylor series in the neighbourhood of a point a middle line of an inclusion.

Стаття надійшла до редколегії 02.12.1999